

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2001年5月17日 (17.05.2001)

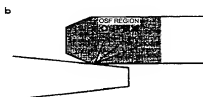
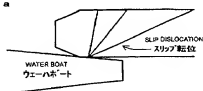
PCT

(10) 国際公開番号  
WO 01/34882 A1

- (51) 国際特許分類: C30B 29/06 (TAMATSUKA, Masaro) [JP/JP]; 〒379-0196 群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会社 半導体機器研究所内 Gunma (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/07641
- (22) 国際出願日: 2000年10月31日 (31.10.2000) (74) 代理人: 弁理士 石原詔二 (ISHIHARA, Shoji); 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目7番8号 若井ビル 302号 Tokyo (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (81) 指定国 (国内): JP, KR, US.
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
- (30) 優先権データ: 特願平 11/320507 1999年11月11日 (11.11.1999) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越半導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および 添付公開書類:  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 玉塚正郎 一 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SILICON SINGLE CRYSTAL WAFER AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

(54) 発明の名称: シリコン単結晶ウェーハおよびその製造方法



(57) Abstract: A silicon single crystal wafer which is improved in a slip resistance at a portion where a CZ silicon single crystal wafer to be heat-treated contacts a heat-treating boat, and which is obtained by a very simple and low-cost method. The silicon single crystal wafer is obtained by pulling up, under a condition that an OSF ring region is formed at the outer peripheral portion of a silicon single crystal rod, the silicon single crystal rod that is grown by a Czochralski method, whereby at least a portion, where the silicon single crystal wafer contacts the boat, consists of the OSF ring region at heat treating.